

# 2SA663

## シリコンPNPエピタキシャルメサ形トランジスタ SILICON PNP EPITAXIAL MESA TRANSISTOR

### ○電力増幅用

#### ○ Power Amplifier Applications

- 大電力 Hi-Fi アンプ出力段に適します:  $P_C=60W(T_C=25^\circ C)$
- 直流電流増幅率の直線性がよい:  $h_{FE}=30\sim 200$
- 高耐圧です:  $V_{CE0}=-80V$
- 飽和電圧が小さい:  $V_{CE(sat)}=-2.3V(Max.)$   
 $I_C=-5A, I_B=-1A$
- 2SC793 とコンプリメンタリで出力50Wが得られます。
- Complementary to 2SC793

#### 最大定格 MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ C$ )

Characteristic	Symbol	Rating	Unit
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CB0}$	-100	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CE0}$	-80	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EB0}$	-5	V
コレクタ電流	$I_C$	-7	A
エミッタ電流	$I_E$	7	A
コレクタ損失( $T_C=25^\circ C$ )	$P_C$	60	W
接合温度	$T_j$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-65~150	$^\circ C$

#### 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ C$ )

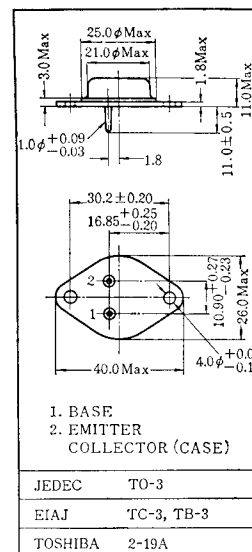
Characteristic	Symbol	Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CB0}$	$V_{CB}=-50V, I_E=0$	—	—	-0.1	mA
エミッタシャ断電流	$I_{EB0}$	$V_{EB}=-5V, I_C=0$	—	—	-1	mA
コレクタ・エミッタ間降伏電圧	$V_{(BR)CE0}$	$I_C=-50mA, I_B=0$	-80	—	—	V
エミッタ・ベース間降伏電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E=-10mA, I_C=0$	-5	—	—	V
直流電流増幅率	Note $h_{FE(1)}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-1A$	30	80	200	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-5A$	15	—	—	
コレクタ・エミッタ間飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-5A, I_B=-1A$	—	—	-2.3	V
ベース・エミッタ間電圧	$V_{BE}$	$V_{CE}=-5V, I_C=-2A$	—	—	-1.2	V
トランジション周波数	$f_T$	$V_{CE}=-5V, I_E=1A$	—	6	—	MHz
コレクタ出力容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz$	—	500	—	pF

Note ;  $h_{FE(1)}$ により下表のように分類し、現品表示してあります。

According to the value of  $h_{FE(1)}$ , the 2SA663 is classified as follows.

Classification	Min.	Max.
2SA663-R	30	70
2SA663-Y	50	120
2SA663-BL	85	200

Unit in mm



アクセサリはAC73を適用  
MOUNTING KIT NO. AC73

#### P<sub>C</sub>-T<sub>a</sub>

